

(4)多晶矽閘極之微影及蝕刻，最後再把光阻移除，即形成poly-Si gate，如圖 6-21 所示。

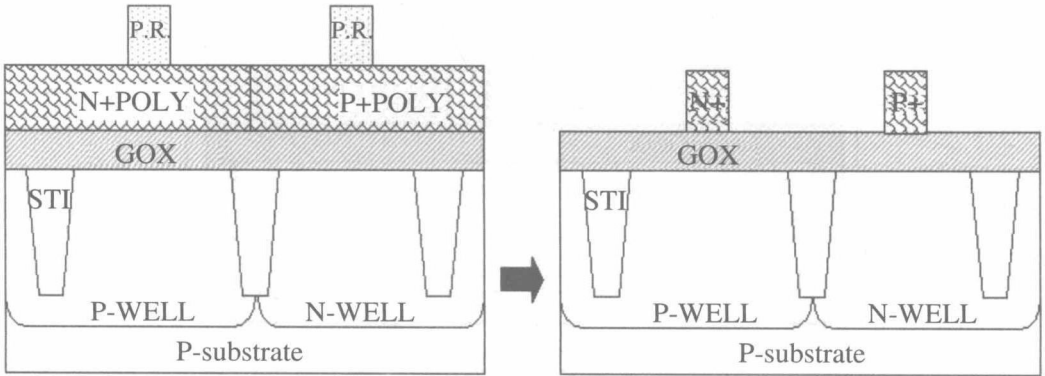


圖 6-21 Poly-silicon gate 之製作流程。

5.輕摻雜汲極（Lightly Doped Drain, LDD）之植入製程

LDD 是一種目前普遍被採用的方法，這個概念就是要將汲極區域的摻雜產生一個梯度的結構，而此製程主要是為了防止所謂的熱載子效應（HCE），主要製程步驟分別是：

(1) N 型輕摻雜汲極（N- LDD）之微影及五價原子植入，再把光阻移除，即形成 N-LDD，如圖 6-22 所示。

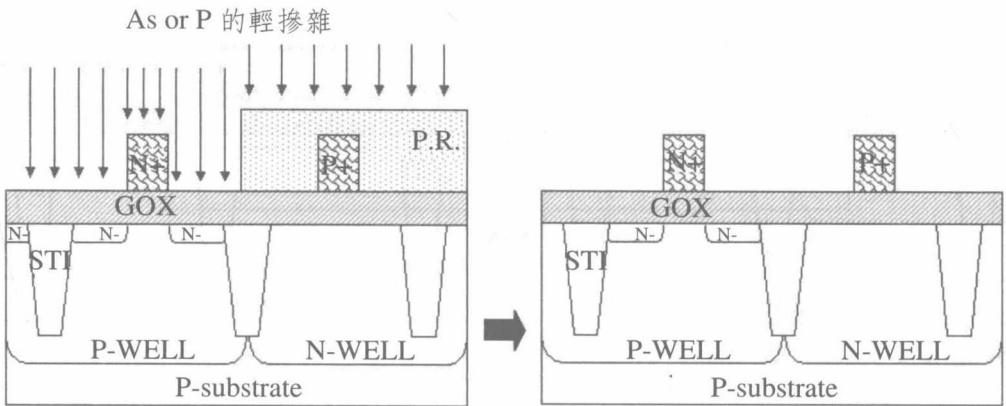


圖 6-22 N-LDD 之製作流程。